

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСЭ СО РАН)

УТВЕРЖДАЮ
директор ИСЭ СО РАН
академик РАН



Ратахин Н. А. Ратахин
« 24 » августа 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
кандидатского экзамена
по специальности
01.04.04 – физическая электроника

основной профессиональной образовательной программы высшего образования — программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки кадров высшей квалификации

№ п/п	Направление подготовки	Наименование ОПОП (профиль подготовки)
1	03.06.01 Физика и астрономия	Физическая электроника

1. Общие положения

- 1.1. Программа кандидатского экзамена разработана на основании:
- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 867;
 - паспорта специальностей научных работников 01.04.04 — физическая электроника;
 - программы-минимум по специальности 01.04.04 — физическая электроника, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274.

2. Порядок проведения кандидатского экзамена

2.1. Прием кандидатского экзамена проводится в сроки, определенные учебным планом основной образовательной программы обучения аспиранта, как правило, в конце 5-ого или в 6-ом учебном семестре.

2.2. Для проведения экзамена назначается экзаменационная комиссия. Председателем комиссии является директор института. Члены комиссии назначаются председателем комиссии из числа высококвалифицированных научных работников института.

2.3. Научный руководитель аспиранта не позднее, чем к началу 5-го семестра обучения аспиранта, разрабатывает и представляет в экзаменационную комиссию дополнительную программу вопросов к экзамену, учитывающую специфику научно-исследовательской работы аспиранта.

2.4. В экзаменационный билет включаются:

- три основных вопроса из программы-минимум по специальности 01.04.04, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274;
- три основных вопроса из дополнительной программы (п. 2.4).

2.5. Экзаменационная комиссия при необходимости задает аспиранту, сдающему экзамен, до трех дополнительных вопросов по материалу программы-минимума и один вопрос по материалу дополнительной программы.

2.6. По итогам кандидатского экзамена составляется протокол, в котором указывается состав экзаменационной комиссии, оценки, полученные аспирантов по каждому из основных и дополнительных вопросов и итоговая оценка по кандидатскому экзамену.

3. Содержание программы-минимум по специальности 01.04.04 — физическая электроника, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274

Из приведенного ниже списка исключаются вопросы: в случае подготовки аспирантом диссертации на соискание ученой степени физико-математических наук — набранные жирным шрифтом (конструкции приборов); технических наук — набранные курсивом.

3.1. Корпускулярная оптика

1. Законы движения заряженных частиц в статических электрических и магнитных полях. Показатель преломления в корпускулярной оптике. Оптический и механический подходы при решении задач корпускулярной оптики. Законы подобия. Параксиальные пучки. Основные свойства аксиально симметричных электростатических и магнитных полей. *Теорема Буша и закон сохранения углового момента. Теорема Лагранжа-Гельмгольца и ее следствия.*

2. Основные типы электростатических линз. Тонкие линзы. Линза-диафрагма. Одиночная линза, иммерсионный объектив и иммерсионная линза. Магнитные линзы. Расчет фокусных расстояний. Линза Глазера. Аберрации линз.

3. Электронные микроскопы. Общие принципы работы. **Конструкции электронных микроскопов.** Особенности электрооптических систем. Корпускулярные микроскопы.

4. Динамика заряженной частицы в переменных во времени полях; движение частиц в полях электромагнитных волн, захват и ускорение, ускорение на биениях.

3.2. Эмиссионная электроника

1. Термоэлектронная эмиссия (ТЭЭ). Работа выхода. Основное уравнение ТЭЭ. Термоэмиссионный метод прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. Вакуумный диод с термокатодом и его вольт-амперная характеристика.

2. Эмиссия под воздействием частиц. Взаимодействие электронов подпороговых энергий с твердым телом. Упругие взаимодействия, сечения процессов. Спектры вторичных электронов. Оже-электроны. Электронно-стимулированная десорбция.

3. Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. Распыление. Механизмы распыления. Формула Зигмунда для коэффициента распыления. Вторичная ионная эмиссия. Коэффициент вторичной ионной эмиссии. Рассеяние ионов низких и средних энергий. Обратное Резерфордское рассеяние. Ионно-электронная эмиссия. Потенциальная и кинетическая эмиссия. Ионно-фотонная эмиссия.

4. Фотоэлектронная эмиссия. Трехступенчатый механизм эмиссии.

5. Автоэлектронная, экзоэлектронная и взрывная эмиссия.

3.3. Вакуумная электроника

1. Формирование электронных пучков большой плотности. Пушка Пирса. Ограничение тока пространственным зарядом. Предельный ток нейтрализованных пучков – ток Пирса. Устойчивость пучков в дрейфовом пространстве, неустойчивости Пирса, диокотронная и токово-конвективная неустойчивости, слипинг-неустойчивость.

2. Спонтанное и вынужденное излучение потоков заряженных частиц. Черенковское, циклотронное (синхротронное) и ондуляторное излучения. Нормальный и аномальный эффекты Допплера. Томсоновское рассеяние.

3. Источники СВЧ-излучения, основанные на вынужденном излучении потоков заряженных частиц: лампа бегущей волны (ЛБВ), магнетроны, гиратроны, убитроны, виркатеры, лазеры на свободных электронах.

4. Релятивистские эффекты, умножение частоты, параметрические усилители и генераторы.

5. Волны пространственного заряда. Пространственная и энергетическая группировки потоков частиц. Нелинейные механизмы насыщения излучения – захват частиц в волнах пространственного заряда, сдвиг резонансной частоты излучения. КПД СВЧ-источников излучения.

3.4. Электроника твердого тела

1. Физические основы электроники твердого тела. Особенности динамики электрона в идеальном твердом теле. Волновая функция, квазиимпульс, зоны Бриллюэна, зонный энергетический спектр, закон дисперсии. Энергетический спектр электрона в кристалле во внешних полях (электрическом и магнитном). Полуклассическая модель динамики электрона в кристалле, границы применимости. Дырки как способ описания ансамбля электронов, свойства и законы движения дырок.

Энергетический спектр электрона в ограниченном кристалле. Условия локализации. Локализованные состояния Тамма. Поверхностные состояния Шокли.

Особенности энергетического спектра электронов в тонких пленках (квантовый размерный эффект).

Типы точечных дефектов в кристаллах. Акцепторные и донорные примеси в полупроводниках. Водородоподобная модель примесного центра.

Неупорядоченные системы – аморфные полупроводники. Понятие идеального аморфного твердого тела (идеального стекла). Случайная структура и случайное поле. Энергетический спектр неупорядоченных систем (без случайного поля и со случайным полем). Дефекты в аморфных материалах.

Статистика носителей заряда в полупроводниках. Обоснование применения статистики Ферми-Дирака к электронам в твердом теле (идеальном). Статистика примесных состояний. Невырожденные и вырожденные полупроводники. Уровень электрохимического потенциала и концентрация свободных и связанных носителей в вырожденных полупроводниках: в собственном, с одним типом примеси, в частично компенсированном. Явление компенсации.

2. Явления переноса заряда в твердом теле.

Интеграл столкновений. Механизмы рассеяния носителей заряда. Электропроводность полупроводников и металлов. Электропроводность в сильных электрических полях. Эффект Ганна. Классический и квантовый размерный эффекты в электропроводности.

Электропроводность в неупорядоченных системах. Прыжковая проводимость по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми (закон Мотта) и хвостах плотности состояний вблизи краев щели подвижности.

3. Неравновесные носители заряда в полупроводниках и диэлектриках. Генерация и рекомбинация. Механизмы рекомбинации.

Диффузия и дрейф неравновесных носителей, соотношение Эйнштейна. Плотность тока и градиент уровня Ферми. Уравнение непрерывности, анализ частных случаев локального возбуждения и инжекции.

4. Контактные явления. Различные типы контактов. Контакт твердое тело – вакуум.

Контакт металл – полупроводник. Диоды Шоттки. Диодная и диффузионная теории выпрямления.

Электронно-дырочный переход. Количественная теория инжекции и экстракции неосновных носителей. Выпрямление и усиление с помощью р-п переходов. Статическая вольт-амперная характеристика (ВАХ) р-п перехода. Туннельный эффект в р-п переходах.

Основные представления о полупроводниковых гетеропереходах, их применение.

5. Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках.

Поглощение и испускание света полупроводниками. *Механизмы поглощения. Поглощение и отражение электромагнитных волн свободными носителями заряда. Поглощение и излучение при оптических переходах зона-зона. Прямые и непрямые переходы. Разрешенные и запрещенные переходы. Спектральные характеристики поглощения кристаллами.*

Спонтанное и вынужденное излучение. Полупроводниковые лазеры. *Оптические свойства аморфных полупроводников. Фотоэффект в р-п переходах. Солнечные батареи. Преобразование электрических сигналов в световые.*

6. Нанoeлектроника. Квантовые ямы и сверхрешетки. Квантовые нити и квантовые точки. Электронные состояния в наноструктурах. *Транспортные явления в низкоразмерных системах. Оптические свойства наноструктур. Одноэлектронные явления в нанoeлектронных устройствах. Нанотехнология. Приборы нанoeлектроники.*

3.5. Физические основы электроники поверхности и пленочной электроники

1. Энергетическая диаграмма реальной поверхности. Поверхностные состояния. Эффект поля и поверхностная проводимость. *Влияние адсорбированных частиц на поверхностную проводимость. Полевые транзисторы.*

2. Проблема микроминиатюризации элементов микроэлектроники. Полупроводниковые, пленочные и гибридные интегральные схемы. Фотолитография, рентгеновская и электронная литографии.

3. Особенности структуры пленок, связанные с характером зарождения.

4. Текстурированные и эпитаксиальные пленки. Структурные несовершенства.

5. Явления переноса в тонких металлических пленках. Дисперсные пленки. Сплошные пленки. Размерные эффекты в пленках.

6. Тонкие диэлектрические и полупроводниковые пленки. Диэлектрические потери.

7. Токопрохождение через диэлектрические слои. Туннелирование. Надбарьерная эмиссия электронов. Токи, ограниченные пространственным зарядом (ТОПЗ).

8. Пленочные активные элементы. Использование неравновесных (горячих) электронов в металлических пленках. Активные элементы, основанные на использовании характеристик с отрицательным сопротивлением. Аналоговые триоды на основе ТОПЗ в диэлектриках. Пленочный полевой триод.

3.6. Методы анализа поверхности и тонких пленок

1. Методики определения плотности поверхностных состояний, основанные на эффекте поля (C-V метод и метод, основанный на изменении поверхностной проводимости).

2. Основы энергоанализа заряженных частиц. Основные типы энергоанализаторов. Методы регистрации частиц. Вторичный электронный умножитель. Детекторы для быстрых частиц (поверхностно-барьерный детектор).

3. Дифракция медленных и быстрых электронов (на просвет и отражение) как методы исследования структуры поверхности.

4. Электронная Оже-спектроскопия. Основное уравнение. Методы количественной Оже-спектроскопии.

5. Фотоэлектронная спектроскопия (ФЭС и УФЭС). Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС или ЭСХА – электронная спектроскопия для химического анализа) и **конструкции приборов**. Химические сдвиги уровней. Количественная РФЭС.

6. Спектроскопия характеристических потерь энергии (СХПЭЭ). **Конструкции приборов**. Одночастичные и многочастичные возбуждения электронов в твердом теле. Количественная СХПЭЭ.

7. Растровая электронная микроскопия. Режимы работы. Особенности формирования контраста. Рентгеновский микроанализ. **Конструкции растровых электронных микроскопов и микроанализаторов**.

8. Туннельная и атомно-силовая микроскопия. Физические основы. **Конструкция микроскопов**. Применения.

9. Методы ионной спектроскопии. Масс-спектрометрия вторичных ионов (МСВИ). Стигматический и растровый режим МСВИ. Ионно-нейтрализационная спектроскопия. Обратное резерфордское рассеяние. Спектроскопия рассеяния ионов низких и средних энергий.

3.7. Функциональная электроника

1. Магнетоэлектроника. Цилиндрические магнитные домены. Магнитные запоминающие устройства: на ферритах и на тонких пленках. 2. Акустоэлектроника: взаимодействие электронов с длинно-волновыми акустическими колебаниями решетки, акустоэлектрический эффект, усиление ультразвуковых волн. Акустоэлектрические явления на поверхностных волнах и их практические применения – малогабаритные линии задержки, усилители и генераторы электрических колебаний.

3. Молекулярная электроника. Основные принципы молекулярной электроники. Электронные возбуждения, используемые для передачи и хранения информации в молекулярных системах. *Перспективы одномерных и квазиодномерных систем, структурная неустойчивость одномерных проводников, переходы Пайерлса и Мотта-Хаббарда. Электронные возбуждения в одномерных системах, солитонная проводимость. Фотопроводимость, нелинейные оптические свойства. Молекулярные полупроводники - полиацетилен и полидиациетилен: структура, свойства, легирование. Приборы молекулярной электроники.*

4. Кривоэлектроника. Электронные свойства твердых тел (металлы, диэлектрики, полупроводники при низких температурах. Явление сверхпроводимости. Эффект Мейснера. Особенности туннелирования в условиях сверхпроводимости.

Высокотемпературная сверхпроводимость. Свойства и параметры сверхпроводников с высокой T_c .

Макроскопические квантовые эффекты сверхпроводимости. Квантование магнитного потока. Эффект Джозефсона. Типы Джозефсоновских переходов. Аналоговые устройства на эффектах Джозефсона. Стандарты напряжения, сквиды, СВЧ приемные устройства.

Цифровые ячейки логики и памяти. Проблемы создания больших интегральных схем (БИС). Особенности электронных устройств на высокотемпературных сверхпроводниках.

4. Литература для подготовки к экзамену

1. Аморфные полупроводники. Под ред. М. Бродски, М., Мир, 1982.
2. Анализ поверхности методами Оже и РФЭС. Под ред. Бригса А. И Сиха М.В., м., Мир, 1987.
3. Афанасьев В.П., Явор С.Я. Электростатические энергоанализаторы для пучков заряженных частиц, Наука, 1978.
4. Беломытцев С. Я., Пегель И. В. Физика сильноточных пучков заряженных частиц. Учебное пособие. – Томск: Издательство ТПУ, 2008. – 115 с.
5. Бинниг Г., Рорер Г. Сканирующая туннельная микроскопия – от рождения к юности, УФН. 1988, т.154, вып.
6. Броудай И., Мерей Дж. Физические основы микротехнологии, М., Мир, 1985, 494 с.
7. Вайнштейн Л. А., Солнцев В. А. Лекции по сверхвысокочастотной электронике. – М.: Советское радио, 1973. – 398 с.
8. Ван Дузер Т., Тренер Ч.У. Физические основы сверхпроводящих устройств и цепей, М., Радио и связь, 1984.
9. Гапонов-Грехов А. В., Петелин М. И. Релятивистская высокочастотная электроника // Вестник АН СССР, 1979, № 4, с. 11-23.
10. Гинзбург В.Л. Сверхпроводимость позавчера, вчера, сегодня, завтра. Успехи физических наук, т. 170, с. 619-630 (2000).
11. Голдстейн Дж. и др. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ, кн. 1 и 2, Мир, 1984.
12. Гусева М.Б., Дубинина Е.М. Физические основы твердотельной электроники, М., МГУ, 1986, 311 с.
13. Добрецов А.Н., Гомоюнова М.В., Эмиссионная электроника.- М.: Наука, 1966.- 564 с.
14. Елифанов Г.И., Мома Ю.А. Физические основы конструирования и технологии РЭА и ВЭА, М., Советское радио, 1979, 352 с.
15. Елифанов Е.И., Мома Ю.А. Твердотельная электроника, М., Высшая школа, 1986, 303 с.
16. Жеребцов И.П. Основы электроники, Л., Энергоатомиздат, 1985.
17. Кельман В.М., Явор С.Я. Электронная оптика, Наука, Л., 1968, 486 с.

18. Кирштейн П., Кайно Г., Уотерс У. Формирование электронных пучков. – М., Мир, 1979.
19. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия / Я.С Уманский., Ю.А. Скаков, А.Н. Иванов, Л.Н. Расторгуев - М.: Металлургия, 1982. – 632 с.
20. Кузелев М. В., Рухадзе А. А., Стрелков П. С. Плазменная релятивистская СВЧ-электроника / Под ред. А. А. Рухадзе. – Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 543 с.
21. Кузелев М.В., Рухадзе А.А. Вынужденное излучение сильноточных релятивистских электронных пучков. УФН, 1987, т.152, вып.2, 285-316 с.
22. Ламперт М., Марк П. Инжекционные токи в твердых телах, М., Мир, 1973.
23. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. I. Механика. М.: Наука, 1988. – 215 с.
24. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. М.: Наука, 1988. – 509 с.
25. Лоусон Дж. Физика пучков заряженных частиц. М. Мир, 1980.
26. Максомов Е.Г. Проблемы высокотемпературной сверхпроводимости. Современное состояние. Успехи физических наук, т. 170, с. 1033-1061 (2000).
27. Маршалл Т. Лазеры на свободных электронах, М., Мир, 1987, 238 с.
28. Месяц Г.А., Эктоны в вакуумном разряде: пробой, искра, дуга.- М.: Наука , 2000.- 424 с.
29. Методы анализа поверхности. Под ред. Зандерны А., М., Мир, 1979, гл.3,4,5.
30. Миллер Р. Введение в физику сильноточных пучков заряженных частиц. – М.: Мир, 1984. – 431 с.
31. Молоковский С.И., Сушков А.Д. Интенсивные электронные и ионные пучки. М.: Энергоатомиздат, 1991. – 304 с.
32. Палатник Л.С., Папилов И.И. Эпитаксиальные пленки, М., Наука, 1971, 480 с.
33. Раховский В.И., Физические основы коммутации электрического тока в вакууме.- М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1970. - 536 с.
34. Рентгенографический электронно-оптический анализ. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Учебное пособие для вузов. – М.: МИСИС, 1994. - 328с.
35. Рухадзе А.А., Богданкевич Л.С., Росинский С.Е., Рухлин В.Г. Физика сильноточных релятивистских электронных пучков. М.: Атомиздат, 1981. – 164 с.
36. Сливков Н.И., Процессы при высоком напряжении в вакууме.- М.: Энергоатомиздат, 1986.- 255 с.
37. Трубецков Д. И., Храмов А. Е. Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков. В двух томах. М.: Физматлит, 2003, 2004.– 496 с, 648 с.
38. Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. М.: Металлургия, 1973. - 584с.
39. Фоменко В.С., Эмиссионные свойства материалов. Справочник.- Киев: Наукова думка, 1981.- 339 с.
40. Чопра К.Л. Электрические явления в тонких пленках, М., Мир, 1972, 435 с.
41. Шевчик В. Н., Шведов Г. Н., Соболева А. В. Волновые и колебательные явления в электронных потоках на сверхвысоких частотах. Изд. Саратов. ун-та, 1962, 334 с.
42. Шимони К., Физическая электроника.- Москва: Энергия, 1977.- 605 с.
43. Шмидт. Введение в физику сверхпроводимости. МЦ. МНО. Москва, 2000.
44. Электронная и ионная спектроскопия твердого тела. Под. ред. Фирменса Л., М., Мир, 1981.

Составитель:

д.ф.-м.н., с.н.с.



И. В. Пегель